

職務経歴書

日付：2010/09/01

氏名：

職務経歴

1985年4月～1994年3月
 技術開発部所属 製作所 中央研究所にて GaAs 製品の開発に従事

1994年4月～1998年3月
 メモリ開発部所属 製作所 導体事業部 FRAMPJ に参画
 256Kb FRAM (1) の開発に従事

1998年4月～現在
 メモリ技術開発部所属 製作所 半導体事業部
 FRAMPJ にてカード搭載用 4Kb FRAM の開発に従事

Point 1

「職務経歴書」の概要を記述することによって、自身の専門分野を紹介することができます。

職務経歴概要

開発期間	職務内容	担当業務	メンバー数
19XX年6月～19XX年3月	GaAs 製品の開発 【対象製品】 GaAs TEG (2) 大型計算機用 4Kb SRAM 光伝送用 2.4Gbps IC 10Gbps IC	・ FET TEG の特性評価 FET の特性ばらつき要因を解明し、デバイス構造の見直しと最適化を検討。 ヘテロ接合を応用したFET の特性を解析し、製造条件、デバイス構造からの最適化を検討。 ・ 線ソフトエラー現象の信頼性評価 線ソフトエラーの発生原因解析とデバイス構造対策を検証、実施。 ・ サイドゲート効果の信頼性評価 隣接 FET による特性変動の原因解析を行い、構造対策を検証、実施。	規模：30名
1994年4月～1998年3月	256Kb FRAM の開発 【対象製品】 FRAM TEG 256Kb FRAM	・ 強誘電体(PZT 3)薄膜特性評価 前工程での特性劣化要因の解析、製造条件対策により完成後の特性劣化を低減。 リテンション、インプリント、ファティーク現象の解明と製造条件の最適化により性能を改善。	規模：14名
1998年4月～2002年6月	4Kb FRAM の開発 【対象製品】 FRAM TEG IC カード	・ リテンション・インプリント現象の製品信頼性評価 製品のリテンション・インプリント現象を解析し、製造条件を最適化して信頼性を向上。 書き換え後の特性を解析し、製造条件の最適化により信頼性を向上。	

Point 2

担当業務、担当役割、開発規模、その他を職務概要に盛り込むことにより、自身の経験/実績を明確にアピールします。

- (1) FRAM : Ferroelectric RAM の略。強誘電体薄膜(PZT)をキャパシタに利用した不揮発性メモリ。
 (2) TEG : Test Element Group の略。プロセス・デバイス用検査素子。
 (3) PZT : P b(Zr, Ti) O3 (チタン酸ジルコン酸鉛)の略。強誘電体メモリのキャパシタ材料。

職務経歴概要

項目	習得技術
テスト設計	・日本HP社 半導体パラメーターアナライザー、LCRメーター
	・日本マイクロニクス社 セミオートマチックプローバー
	・エスベック社 フラッシュメモリ温度サイクル試験装置
	・ケーデンス社 Composer
回路設計	・ケーデンス社 Composer
	・Avant社 HSPICE
レイアウト設計	・ケーデンス社 Virtsuso
	・セイコーインスツルメンツ社 SX-9000

Point 3

職歴概要と併せて記述することによって、職歴紹介を効果的にアピールし、自身の技術スキルを明確にアピールします。

特許論文

項目	内容
特許	(チップ剥離防止)特許出願(1988)
論文	GaAs 線ソフトの評価(研究報告,1987)
	N. Futigami, Y. Kawata,,
	Temperature Dependence of Gate
	ED-615, 1994.
	I 256K FRAM用強誘電体薄膜の劣化特性の検討(研究報告,1998)

Point 4

年代別に盛り込むことにより、自身の経験/実績をより効果的にアピールします。

表彰他

社長技術賞3等	光伝送用GaAs ICの特性評価技術の開発(1988年度)
社長技術賞3等	GaAs 4Kb SRAMの開発(1989年度)
社長技術賞奨励賞	FRAM評価手法の確立(1996年度)

Point 5

特許/論文同様に盛り込むことによって、社内での自身の経験/実績をより効果的にアピールします。

自己PR

製品信頼上の問題をTEGの評価で掘り下げて解析し、製造条件とデバイス構造の最適化による改善で製品信頼性の向上を行って来ました。

GaAsの開発は線ソフトエラー現象とサイドゲート効果の対策に取り組み、線ソフトエラー現象は線で発生した電荷の測定と電荷の流れを解析し、電荷の流入を防ぐ構造を適用して線ソフトエラーに強い製品を開発しました。

またアナログICの隣接した素子間の特性が変動するサイドゲート効果は、変動原因のリーク電流を低減する構造の検討を行い、素子間を分離した構造で製品を実用化しました。

FRAMの開発はリテンション・インプリント・ファティーグ特性の改善に取り組みました。

強誘電体は水素に弱いため、リテンション・インプリント・ファティーグ特性の改善は水素の侵入を防ぐ強誘電体キャパシタ構造の検討とともに水素の発生を抑えたパッケージ封止方法・レジン材料の検討も行ないました。この検討と強誘電体特性の工程劣化対策を行った結果、製品のリテンション・インプリント・ファティーグ特性が改善して信頼性の向上につながりました。

GaAsの開発業務では半導体材料の性質とデバイス構造に基づいた評価を行い、さらにFRAMの開発業務をとおして半導体材料の性質とデバイス構造に加えて製造工程も含めた評価に取り組んで来ました。私の評価経験は半導体製品の品質向上、改善で応用できると考えております。

Point 6

特別に記述する必要はありませんが、職務内容で表現できない経験や実績をアピールする場として活用でき、且つ業務に対する貢献度を効果的にアピールすることに有用的であると言えます。

以上

書類選考通過への 重要 Point !

職務経歴書の記述する順番、内容、表示の仕方によって、経験やスキルをアピールするポイントが変わります。そのポイントがずれてしまうと、自身の職務経歴が効果的に表現されない、ということもあります。

職務経歴書は自分自身のパンフレットのようなものですが、作成する際に、今までのキャリアの棚卸しをすることで、面接に向けた準備となります。面接の流れをイメージしながら、相手に見やすく、有効的に伝わるような書き方で、今まで培ってきた業務経験とその能力をしっかりとアピールしましょう。

また、見やすい統一感のあるレイアウトを意識し、要点を明確にした文章構成にすることも大切です。